

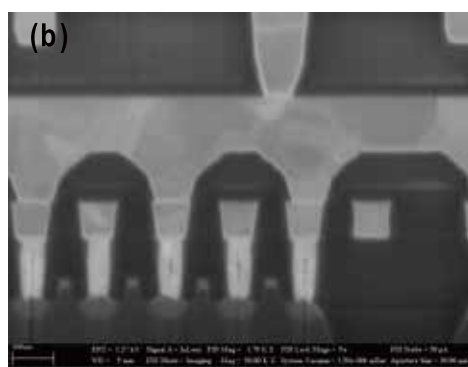
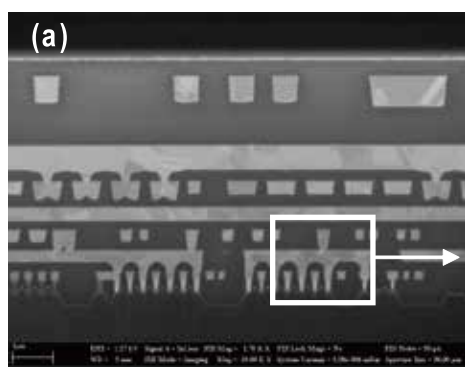
クロスビーム FIB による断面観察

半導体デバイス、MEMS、TFT トランジスタなどナノスケールの精度で製造されるエレクトロニクス製品の構造解析を行うための新たな手法：クロスビーム FIB により断面観察をご提案いたします。

特長

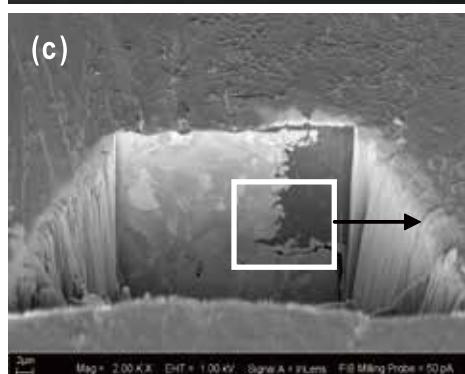
- 1) FIB 加工をリアルタイムで観察できるため目的の箇所を確実に捉えます。
- 2) 2つの二次電子検出器 (In-lens/ チャンバー SE) により試料からの様々な情報が得られます。
- 3) 加工用 FIB と観察用低加速 SEM を1つのチャンバーに集約し大気に曝すことなく観察。
- 4) 拡散層：NP 界面の可視化が可能。N+/N-, 及び P+/P- の濃度差は検出不可。

観察例



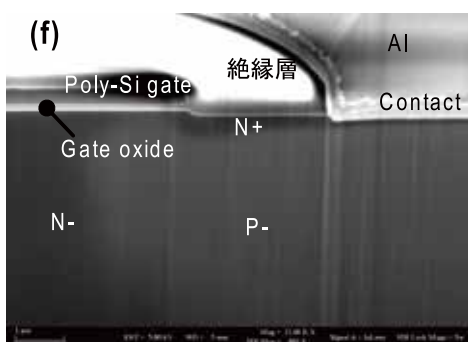
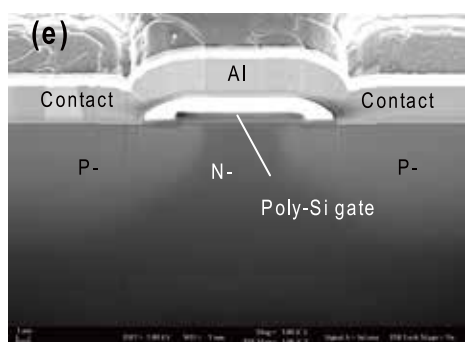
(a) ULSI Pentium-4
FIB 断面加工後
SEM 観察

(b) (a) 中の白枠部分
の拡大観察



(c) ビルドアップ
基板の銅配線
断面加工後
SEM 観察

(d) (c) 中の白枠
部分の拡大観察



(e) MOS-FET ゲート
部の拡散層観察

(f) (e) の拡大観察

お問い合わせは
こちらまで

株式会社アイテス
品質技術部

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅 800 番地
TEL: 077-599-5020 FAX: 077-587-5901
URL: <http://www.ites.co.jp>